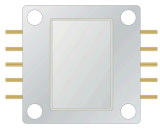
8000–12000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 46 dBm (典型值)

LCI-PA-8000-12000-PS46T · 8000–12000 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT 46 dBm (典型值); 功率增益 24 dB (典型值); PAE 37 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.



FPC1515-10

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 5

RFin: 3

Vd: 6, 10

RFout: 8

NC: 2, 4, 7, 9

封装外形尺寸: 15.24 × 15.24 × 1.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	8000	-	12000	MHz
饱和输出功率	-	-	46	-	dBm
功率增益	-	-	24	-	dB
功率附加效率	-	-	37	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	±0.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	27	dBm

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	15.24 × 15.24 × 1.4	mm

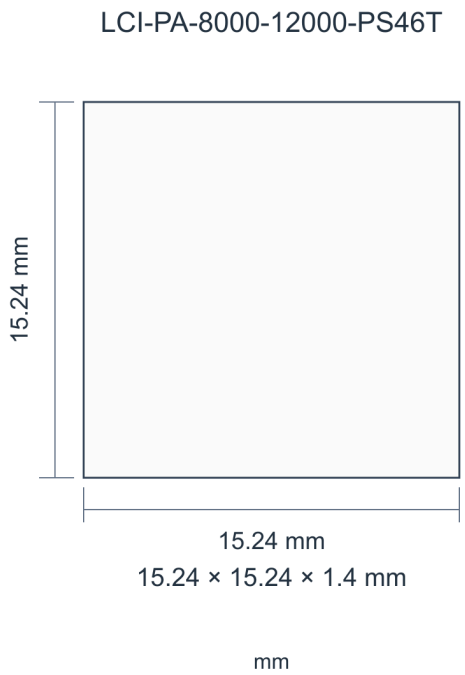
当前出版记录 · 1.8 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.7.

集成说明

FPC1515-10 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 5 RFin: 3 Vd: 6, 10 RFout: 8 NC: 2, 4, 7, 9

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

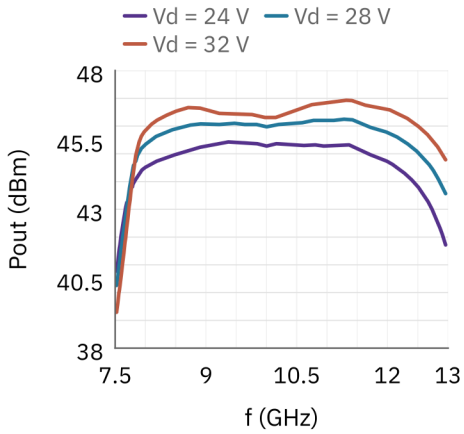


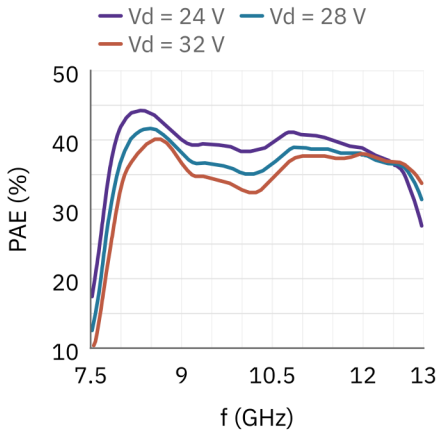
性能曲线

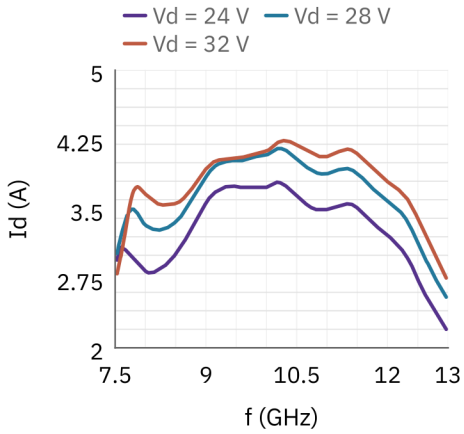
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

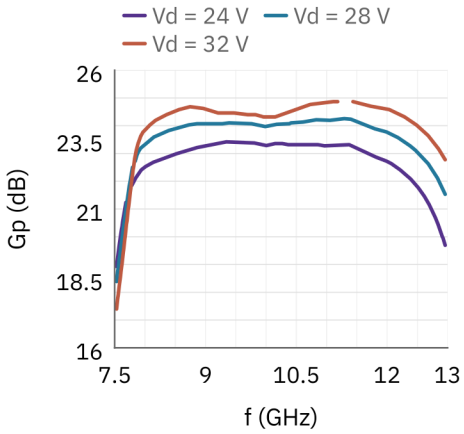
输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。

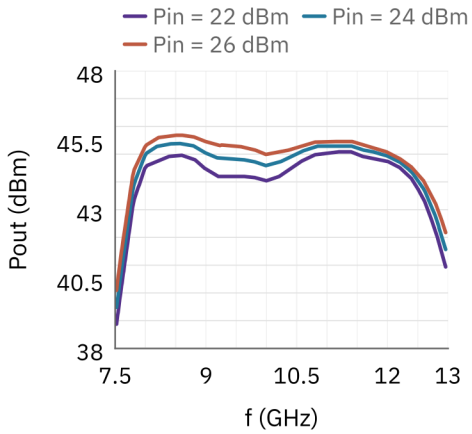
图中读数为近似值。 前四幅图为脉冲条件：PW = 100 µs；D = 10%；Pin = 22 dBm；Vg = −2.4 V；Temp = +25 °C；Vd 按各曲线图例为 24/28/32 V。底部 Pout 和 PAE 图为 CW 条件：Vd = 28 V；Vg = −2.4 V；IDQ = 2.2 A；Temp = +25 °C；Pin 按各曲线图例为 22/24/26 dBm。

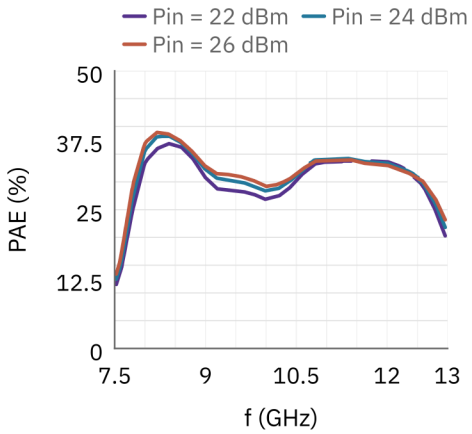


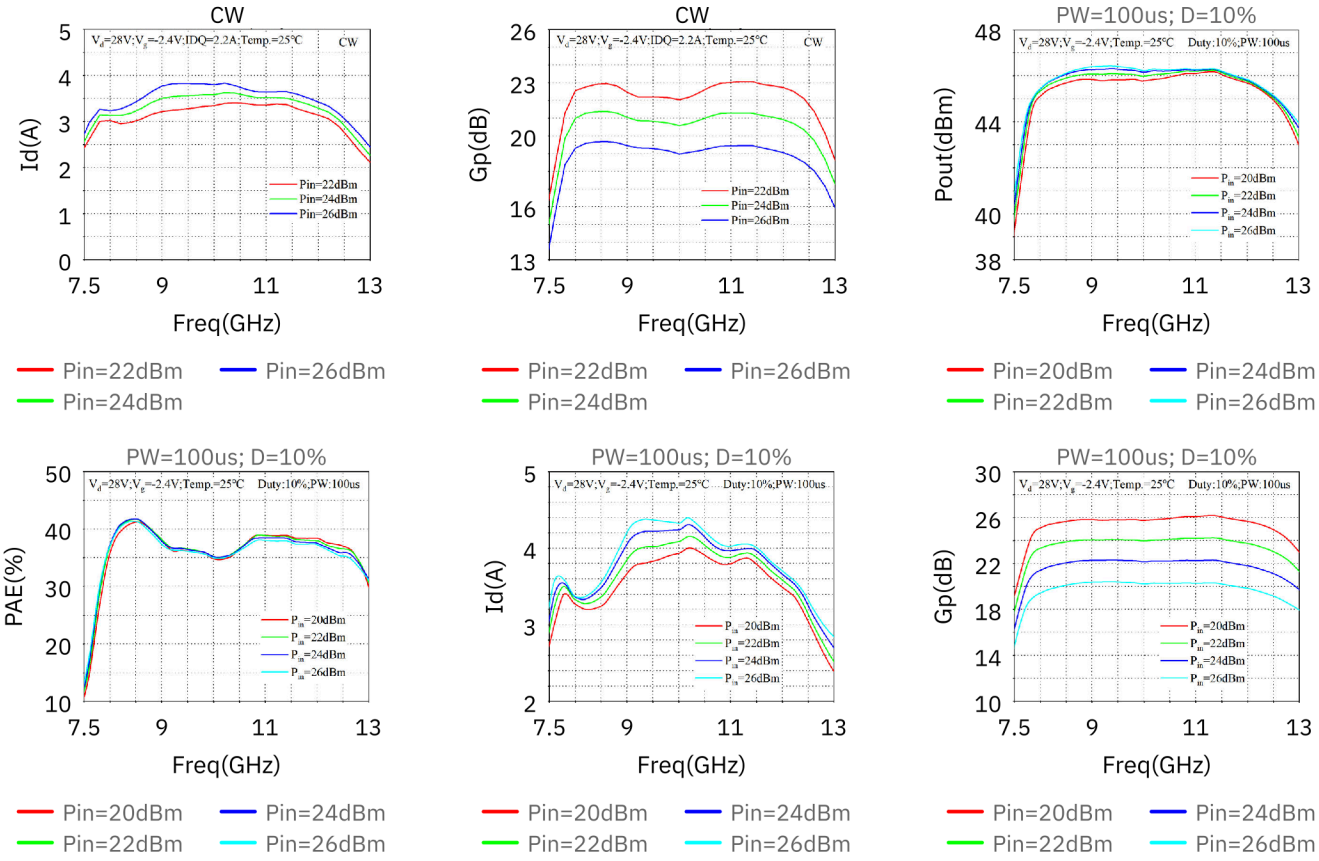












输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C. 第1–2图： CW; IDQ = 2.2 A; Pin = 22/24/26 dBm。第3–6图： PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 20/22/24/26 dBm。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。